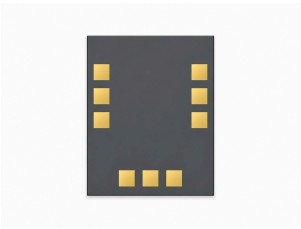
12000–18000 MHz Chip divisor de potencia GaAs IPD de 2 vías y 0°

LCDIV-12000-18000-2WAY es un chip divisor de potencia GaAs IPD de 2 vías y 0° para 12000–18000 MHz.

Aislamiento: 25 dB (típico); VSWR de entrada: 1.2 (típico); VSWR de salida: 1.1 (típico). Dimensiones del die: 0.8 × 1 × 0.1 mm.



Características RF

TA = +25 °C

Parámetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Unidad
Frecuencia de funcionamiento	-	12000	-	18000	MHz
Aislamiento	-	-	25	-	dB
VSWR de entrada	-	-	1.2	-	-
VSWR de salida	-	-	1.1	-	-

Valores límite

Parámetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Unidad
Potencia de entrada máxima	-	-	-	30	dBm

Condiciones ambientales

Parámetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Unidad
Temperatura de almacenamiento	-	-65	-	150	°C
Temperatura de funcionamiento	-	-55	-	85	°C

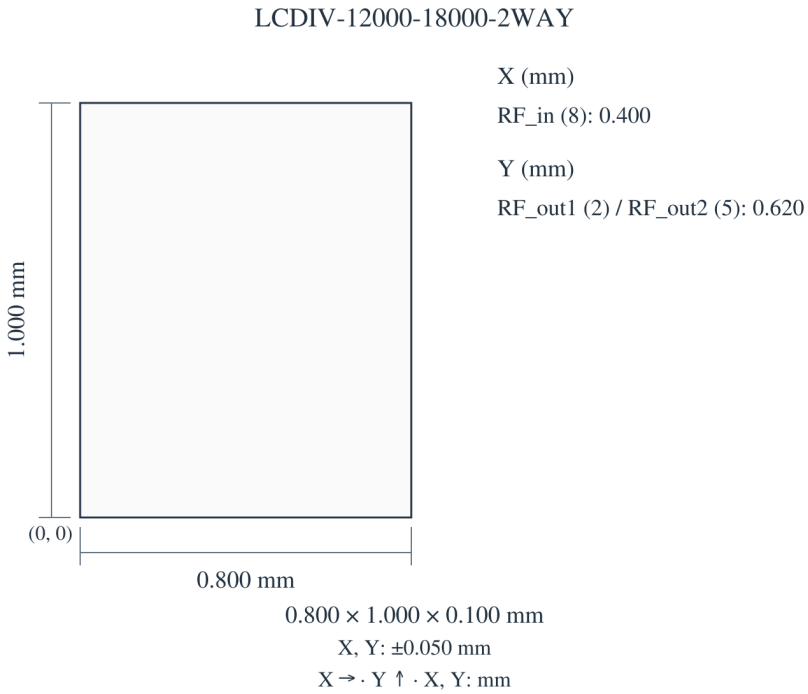
Asignación de pads de unión

Terminales	Símbolo	Función	Notas
1, 3, 4, 6, 7, 9	GND	Masa; no requiere hilo de unión	-
2	RFout1	Salida RF	1
5	RFout2	Salida RF	2
8	RFin	Entrada RF	-

Dimensiones del chip

Parámetro	Valor	Unidad
Dimensiones del chip	0.8 × 1 × 0.1	mm

Plano de referencia con algunas dimensiones en mm. Utilice los planos completos para la fabricación y la unión por hilos.



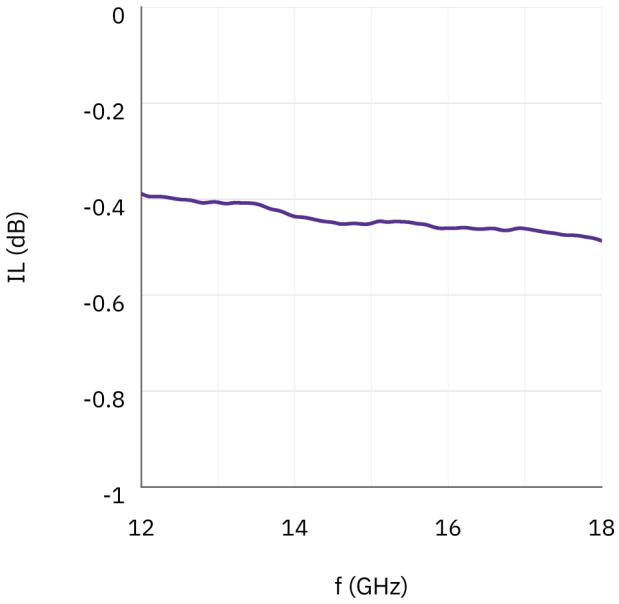
Registro de la publicación actual · 1.6 · 2026-11-12. Actualización de la descripción o del contenido editorial. Sustituye a la revisión 1.5.

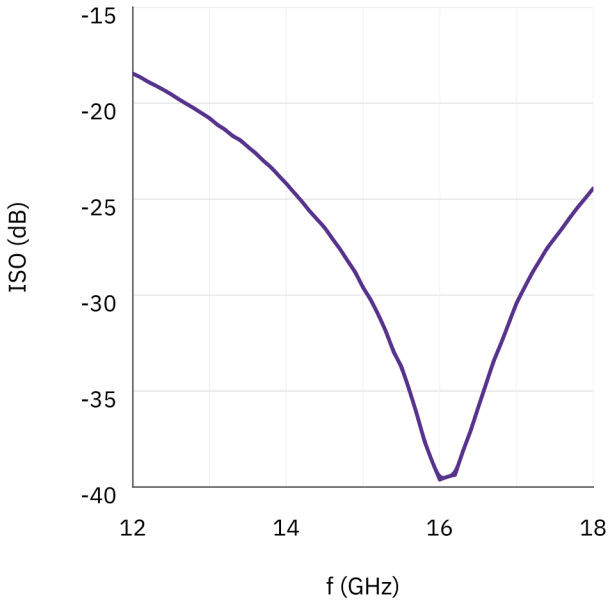
Curvas de rendimiento

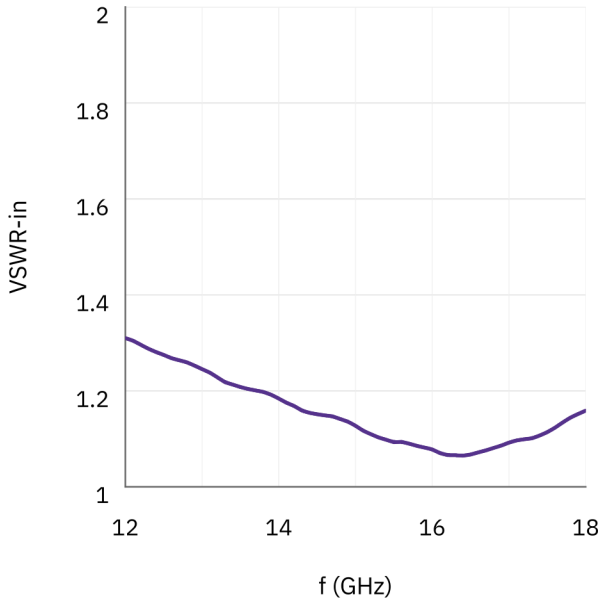
Consultar cada figura junto con las condiciones de funcionamiento indicadas.

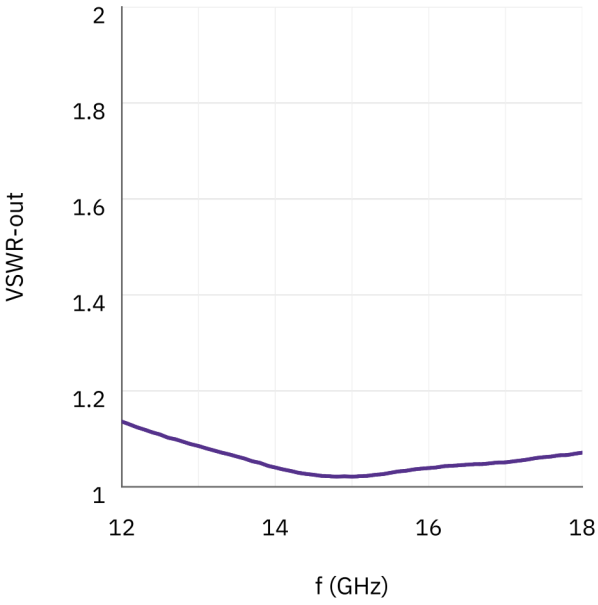
Pérdida de inserción; Aislamiento; Adaptación de entrada; Adaptación de salida.

Las lecturas son aproximadas.









Aviso del documento

Las especificaciones pueden revisarse. Antes de cerrar el diseño, confirme con LCRF la revisión vigente y los requisitos específicos del producto. La oferta aprobada y la documentación del pedido definen la configuración suministrada.